



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

H2907A

对应国外型号

KTN2907A

主要用途

放大、开关应用。

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极耗散功率.....	625mW
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	-60V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	-60V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	-5V
I_C ——集电极电流.....	-600mA

外形图及引脚排列

TO-92



- 1—发射极, E
- 2—基 极, B
- 3—集电极, C

电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	-60			V	$I_C=-10\mu A, I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-60			V	$I_C=-10mA, I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	$I_E=-10\mu A, I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-10	nA	$V_{CB}=-50V, I_E=0$
$H_{FE}(1)$	直流电流增益	75				$V_{CE}=-10V, I_C=-0.1mA$
$H_{FE}(2)$		100		300		$V_{CE}=-10V, I_C=-150mA$
$H_{FE}(3)$		50				$V_{CE}=-10V, I_C=-500mA$
$V_{CE(sat1)}$	集电极—发射极饱和电压			-0.4	V	$I_C=-150mA, I_B=-15mA$
$V_{CE(sat2)}$				-1.6	V	$I_C=-500mA, I_B=-50mA$
$V_{BE(sat1)}$	基极—发射极饱和电压			-1.3	V	$I_C=-150mA, I_B=-15mA$
$V_{BE(sat2)}$				-2.6	V	$I_C=-500mA, I_B=-50mA$
f_T	特征频率	200			MHz	$V_{CE}=-20V, I_C=-50mA, f=100MHz$
C_{ob}	共基极输出电容			8	pF	$V_{CB}=-10V, I_E=0, f=1MHz$
t_{ON}	导通时间			45	ns	$V_{CC}=-30V, I_C=-150mA, I_{B1}=-15mA$
t_D	延迟时间			10	ns	
t_R	上升时间			40	ns	
t_{OFF}	关闭时间			100	ns	$V_{CC}=-6V, I_C=-150mA, I_{B1}=I_{B2}=-15mA$
t_{STG}	贮存时间			80	ns	
t_F	下降时间			30	ns	

